

DSRC 송신기를 위한 능동발룬 내장형 5.8 GHz SiGe 상향믹서 설계 및 제작

정희원 이 상 흥*, 이 자 열*, 김 상 훈*, 배 현 철*, 강 진 영*, 김 보 우**

A 5.8 GHz SiGe Up-Conversion Mixer with On-Chip Active Baluns for DSRC Transmitter

Sang heung Lee*, Ja yol Lee*, Sang hoon Kim*, Hyun cheol Bae*

Jin yeong Kang*, Bo woo Kim** *Regular Member*

요 약

근거리무선통신 (Dedicated Short Range Communication, DSRC)은 지능형교통시스템 서비스 제공을 위한 통신 수단으로, 수 미터에서 수백 미터인 근거리 영역의 노변장치(Road Side Equipment, RSE)와 차량탑재장치(On-Board Equipment, OBE)와의 양방향 고속통신을 수행하는 통신시스템이다. 본 논문에서는 SiGe HBT 공정을 이용하여 근거리무선통신 송신기용 5.8 GHz 상향믹서를 설계 및 제작하였다. 설계된 상향믹서는 믹서코어 회로와 더불어 IF/LO/RF 입출력 정합 회로, IF/LO 입력 발룬 회로와 RF 출력 발룬 회로가 단일칩으로 구현되었다. 제작된 상향믹서는 2.7 mm X 1.6 mm의 크기를 가지며, 3.5 dB의 전력변환이득과 -12.5 dBm의 OIP3, 42 dB의 LO to IF isolation, 38 dB의 LO to RF isolation, 3.0 V의 공급전압 하에서 29 mA의 전류소모로 측정되었다.

Key Words : SiGe, HBT, Mixer, Balun, ITS, DSRC

ABSTRACT

DSRC provides high speed radio link between Road Side Equipment and On-Board Equipment within the narrow communication area. In this paper, a 5.8 GHz up-conversion mixer for DSRC communication system was designed and fabricated using 0.8 um SiGe HBT process technology and IF/LO/RF matching circuits, IF/LO input balun circuits, and RF output balun circuit were all integrated on chip. The chip size of fabricated mixer was 2.7 mm X 1.6 mm and the measured performance was 3.5 dB conversion gain, -12.5 dBm output IP3, 42 dB LO to IF isolation, 38 dB LO to RF isolation, current consumption of 29 mA for 3.0 V supply voltage.

1. 서 론

지능형교통시스템(Intelligent Transportation Systems, ITS)은 전자 정보 제어 등 첨단 기술을 활용해 실시간 교통정보를 수집 관리 제공해 기존 교통시설의 이용효율을 극대화하는 차세대 교통체계로서, 교

통량의 변화에 따른 실시간 교통신호 제어, 요금징수 자동화, 사고 등 돌발 상황에 대한 신속한 조치, 실시간 교통정보 및 우회경로 정보를 제공함으로써 교통체증을 감소시키며, 운전자에게 최적 이동시간, 이동 수단 및 이동 경로에 선택권을 줌으로써 합리적으로 시간과 공간을 활용할 수 있도록 해준다. 근

* 한국전자통신연구원 기반기술연구소 고속집적회로연구부 SiGe소자팀(shl@etri.re.kr)

** 한국전자통신연구원 기반기술연구소 고속집적회로연구부

논문번호 : KICS2005-03-106, 접수일자 : 2005년 3월 15일

거리무선통신(Dedicated Short Range Communication, DSRC)은 지능형교통시스템 서비스를 제공하기 위해 도입된 새로운 통신 수단으로, 수 미터에서 수백 미터인 근거리 영역의 기지국 장치인 노변장치(Road Side Equipment, RSE)와 이 통신영역을 통과하는 차량탑재장치(On-Board Equipment, OBE)와의 점대점(point-to-point) 또는 점대다점(point-to-multipoint) 양방향 고속통신을 수행하는 통신시스템이다. 이 근거리무선통신 시스템은 세계적으로 개발되어 왔으며 최근에는 전자 요금징수(electric toll collection)에 적용되고 있으며, 대부분의 지능형교통시스템 서비스는 근거리무선통신에 의해 제공될 것으로 보인다[1]. 지능형교통시스템 서비스가 조기에 정착되고, 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 차량탑재장치의 저가격화, 소형화를 우선적으로 해결해야 하며, 이를 위해서는 차량탑재장치 내부의 회로에 대하여 MMIC화가 필요하다[2].

SiGe 이종접합 바이폴라 트랜지스터는 기존의 실리콘 바이폴라 접합 트랜지스터의 베이스 층을 실리콘(Si) 대신 SiGe 에피층으로 대체한 것이다. npn형 SiGe 이종접합 바이폴라 트랜지스터의 경우, SiGe으로 이루어진 베이스가 실리콘으로 이루어진 에미터 및 컬렉터에 비해 더 작은 에너지 밴드갭(energy bandgap)을 가지므로 에미터에서 베이스로의 전자방출은 용이해지는 반면에 베이스에서 에미터로의 정공 방출은 억제된다. 이로 인해 SiGe 이종접합 바이폴라 접합 트랜지스터는 실리콘 바이폴라 접합 트랜지스터에 비해 매우 높은 에미터 방출 효율(emitter injection efficiency)과 전류이득을 나타내며, 따라서 충분히 큰 전류이득을 유지하면서도 베이스 층의 불순물 농도를 충분히 증가시켜 베이스 저항을 감소시킨다. 뿐만 아니라, 'punch through'에 대한 저항성을 높여 보다 얇은 베이스의 사용을 가능하게 한다. 또한, Ge 농도에 대한 적당한 기울기를 주어 베이스 내부에 전기장을 형성하면 베이스를 통과하는 전자들을 보다 빠르게 가속시킬 수 있는데, 이러한 여러 가지 요인들로 인하여 SiGe 이종접합 바이폴라 트랜지스터는 기존의 실리콘 바이폴라 접합 트랜지스터에 비해 월등히 높은 차단주파수 및 최대 발진주파수 값을 나타낸다[3].

상향믹서(up-conversion mixer)는 IF(Intermediate Frequency) 신호를 RF(Radio Frequency) 신호로 변환하는 것으로서 라디오 시스템에 매우 중요한 빌딩 블록이며, 이의 특성이 전체 시스템의 성능과 다른 빌딩 블록의 성능에 영향을 준다. 한편, RF

집적회로에서는 차동형 증폭기나 길버트 셀 믹서(Gilbert cell mixer)와 같은 차동형 구조가 많이 쓰이며, 이들 회로들은 기본적으로 대칭구조(balanced structure)이다[4,5,6]. 대칭 구조와 비대칭 구조의 인터페이스를 위하여, 대칭 신호와 비대칭 신호간의 신호 변환을 수행하는 발룬(balance+unbalance, Balun)이 필요하다. 즉, 발룬은 비대칭 신호를 대칭신호로 변환하거나, 혹은 그 반대의 경우를 수행한다. 발룬은 크게 수동 발룬과 능동 발룬으로 나누어지며, 특히 MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuits)에서는 전송선(transmission line)을 이용한 발룬과 수동소자를 이용한 발룬은 상당한 면적을 차지하므로 온칩화에 걸림돌로 작용하며, RF-SoC화의 추세에 따라 능동 발룬의 필요성이 증대된다. 능동 발룬의 경우, 부가적인 회로의 첨가에 따른 잡음지수(Noise Figure, NF)와 전력소모가 증가하나 RF-SoC에 매우 적합하며 발룬 자체에서 이득을 확보할 수 있어 본 회로와의 결합에 있어서 이득 확보가 용이하다.

본 논문에서는 한국전자통신연구원에서 자체 개발한 SiGe HBT 소자를 사용하여, IF/LO/RF 입출력정합 회로, IF/LO 입력의 능동발룬 회로 및 RF 출력의 능동발룬 회로를 내장하여 5.8 GHz DSRC 송신기용 상향믹서를 설계 및 제작하였다. 본 논문에서 설계 및 제작한 하향믹서는 2.7 mm X 1.6 mm의 크기를 가지며, 3.5 dB의 전력변환이득과 -12.5 dBm의 OIP3, 42 dB의 LO to IF isolation, 38 dB의 LO to RF isolation, 3.0 V의 공급전압 하에서 29 mA의 전류소모로 측정되었다.

II. SiGe 능동소자와 수동소자의 특성 및 모델

본 논문에서는 한국전자통신연구원에서 자체 개발한 SiGe 이종접합 바이폴라 트랜지스터와 집적회로 공정상에서 능동소자와 함께 개발된 수동소자를 사용하여 회로를 설계하였다.

서론에서 언급한 바와 같이, SiGe 이종접합 바이폴라 트랜지스터(Heterojunction Bipolar Transistor, HBT)는 전류이득, 전력소모, 차단주파수(f_r , cut-off frequency) 및 최대 발진주파수(f_{max} , maximum oscillation frequency)와 같은 전기적 성질이 실리콘 바이폴라 접합 트랜지스터 보다 우수하기 때문에, 실리콘 바이폴라 접합 트랜지스터 보다 RF 집적회로에 더 적합한 것으로 간주되고 있다. 그림 1은 본 논문에 사용된 능동소자인 SiGe 이종접합 바이폴라

트랜지스터의 단면도이며, 트랜지스터 제조시 베이스 에피층 성장을 위해 RPCVD (Reduced-Pressure Chemical Vapor Deposition)를 사용한다. 또한, Ge의 농도에 대한 기울기는 17%에서 0%로 점차 감소시켜 제조되며, CMOS와의 동시 제조를 고려하고 소자간 격리를 위해 LOCOS 격리 (isolation)를 채택한다. 설계에 사용된 SiGe 이종접합 바이폴라 트랜지스터는 에미터 면적이 $0.5 \times 6.0 \mu\text{m}^2$ 이고 DC 전

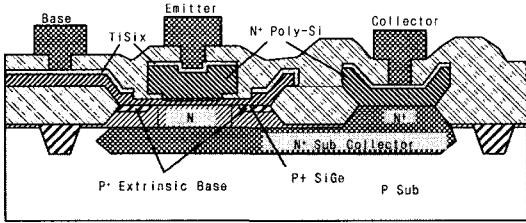


그림 1. 제작된 SiGe HBT 단면도.

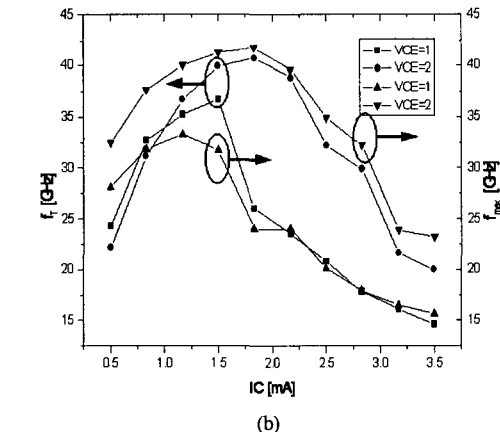
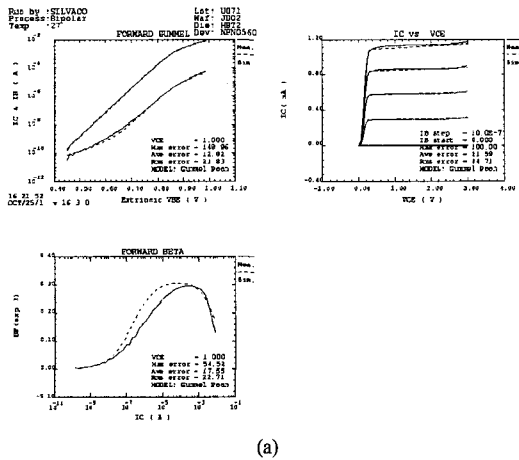


그림 2. SiGe HBT의 DC 및 AC 특성. (a) DC 특성 및 모델링 결과, (b) AC 특성.

류이득이 296이며, BVCEO는 3.5 V이고, 컬렉터 전류 1.84 mA에서의 f_T 와 f_{max} 가 각각 41 GHz와 42 GHz이다. 능동소자의 모델링에는 SPICE Gummel-Poon (SGP) 모델이 사용되었으며, AC 소신호의 경우 500 MHz~10 GHz에서 모델링하였다. 능동소자의 보다 상세한 DC 및 AC 특성은 그림 2와 표 1에, 능동소자의 DC모델링 결과는 그림 2(a)에, 대표적으로 컬렉터 전류 1mA에서의 AC 소신호 모델링 결과는 그림 3에 각각 나타내었다.

표 1. SiGe HBT의 DC 및 AC 특성.

소자 변수	측정값
에미터 면적[μm^2]	0.5 x 6.0
DC 전류이득	296
BVEBO[V]	0.95
BVCBO[V]	10.7
BVCEO[V]	3.5
RC[Ohm]	61
RE[Ohm]	30
f_T [GHz]	41
f_{max} [GHz]	42

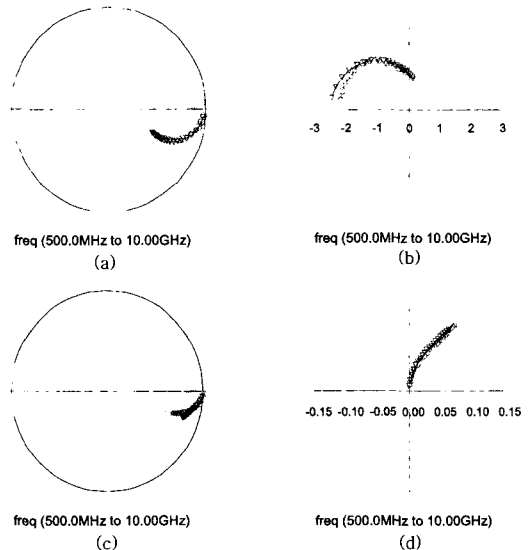


그림 3. IC=1mA에서의 SiGe HBT의 AC 모델링 결과. (a) S11, (b) S21, (c) S22, (d) S12.

본 논문에서 사용된 수동소자는 2개의 금속층 (2-metal layers)을 사용하여 제조되는데, 그 특성은 표 2와 같다. 커패시터는 p-형 실리콘 기판위에 SiO₂를

형성하여 SixOy 유전막을 증착하여 제작한 MIM 커패시터이다. 커패시터 등가 모델은 그림 4와 같이 기판 (Si)과 SiO₂ 성분을 각각 저항과 커패시터 성분으로 고려하여 모델하였으며, 면적으로 정규화한 커패시턴스의 값은 0.84 fF/um²이다. 인덕터는 알루미늄 (Al) 금속 공정을 그대로 적용한 병렬분기형 스파이럴 (spiral) 인덕터[7]이며, 등가 모델은 그림 5와 같이 일반적으로 알려진 모델을 사용하였으며, 기생성분 (Cox, Csi, Rsi 등)과 인덕터 자체의 고유 성분 (Cf, L, Rs) 등으로 구성된다. 또한, 저항은 기본적으로 저저항, 중저항 및 고저항의 세 종류로 구성되며 모두 bar-형이다. 저저항은 금속 저항으로 TiN/Ti/TiN 다층 박막을 1차 금속 위의 절연 산화막에 형성시켜 만든 것으로 시트저항 값은 9 ω /□이다. 중저항의 에미터 저항은 SiGe 이중접합 바이폴라 접합 트랜지스터의 에미터 형성시 옥사이드 (oxide) 위에 동시에 구현되는 것으로 시트저항 값은 50 ω /□이며, 고저항의 베이스 저항은 SiGe 이중접합 바이폴라 접합 트랜지스터의 베이스 형성시 옥사이드 (oxide) 위에 동시에 구현되는 것으로 시트저항 값은 800 ω /□이다.

표 2. 수동소자의 특성.

수동소자 종류	수동소자 특성			
	종류	박막	면저항	편차[%]
저항	저저항	TiN/Ti/TiN	9 ω /□	< 3
	중저항	에미터 폴리	50 ω /□	< 5
	고저항	베이스 폴리	800 ω /□	< 9
인덕터	인덕턴스[nH]	Q 값@2~6GHz	공진주파수[GHz]	
	1.5	> 11	> 25	
	2.7	> 8	> 14	
	4.3	> 7	8.6	
커패시터	박막	SiOxNy 두께 [nm]	정전용량 [fF]	편차 [%]
	Al/SixNy/Al	75	0.84	3

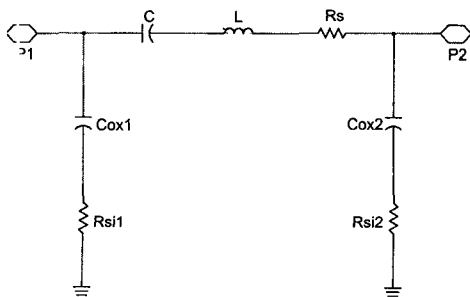


그림 4. 커패시터 등가모델.

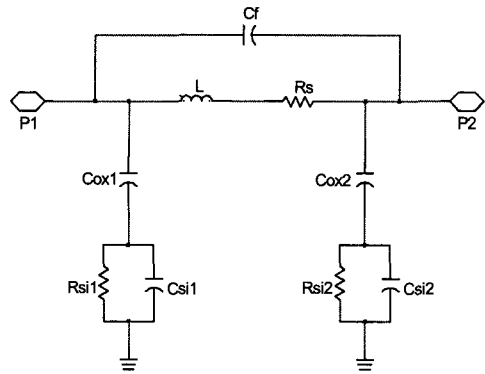


그림 5. 인덕터 등가모델.

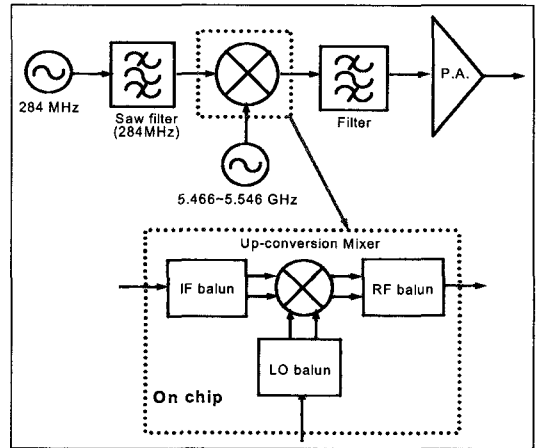


그림 6. DSRC RF front-end 송신기용 상향믹서 구조

III. DSRC 송신기용 5.8 GHz 상향믹서 설계

본 논문의 DSRC RF front-end 송신기용 믹서 구조를 그림 6에 나타내었다. 중간주파수증폭기 (Intermediate Frequency Amplifier, IFA)와 국부발진기 (Local Oscillator, LO)의 단일 신호 출력을 받아 입력 발룬에서 차동 신호로 변환하여 길버트 셀 믹서에서 상향주파수변환(up-conversion)을 수행한 후 출력 발룬이 단일 신호로 변환하여 출력한다. 본 논문의 상향믹서의 구체적인 신호처리 방법은 다음과 같다. 먼저, (1) IF 및 LO 입력을 받아 각각 정합회로 및 발룬회로를 통과하여 차동 신호로 변환한 후, (2) degeneration 인덕터가 있는 길버트 셀에서 상향주파수 변환을 수행하여 증폭한 후, (3) 증폭된 RF 신호는 RF 출력 발룬과 정합회로를 거쳐 단일신호로 최종 출력된다. 단, DC 블로킹 (blocking)을 위하여 각 단마다 0.1 pF의 커패시턴스를 갖

는 MIM 커패시터를 사용하였다. 이때, IF 신호의 중심주파수는 284 MHz이고 LO 신호의 중심주파수는 5.506 GHz이며 RF 출력주파수는 5.790 GHz이다. 입력 및 출력 모두에 사용된 발룬은 능동 발룬으로 정합회로 및 길버트셀 믹서와 함께 단일칩으로 구현되었다. 능동 발룬의 사용으로 인한 잡음지수와 전력소모의 증가가 있지만 발룬 자체에서 이득을 확보할 수 있어 믹서코어 회로와의 결합에 있어서 이득 확보가 용이하며 무엇보다도 RF 블록의 온칩화에 적합하다.

그림 7은 IF 또는 LO 입력 단에 사용된 차동형 발룬 회로로서, 단일 입력 신호를 받아 대칭의 차동 신호로 변환하여 길버트 셀 믹서에 차동 신호를 공급한다. 단일 신호 입력이 트랜지스터 Q1의 베이스에 가해지고, DC 전위가 같은 두 트랜지스터 Q1과 Q2의 컬렉터 사이에 출력이 측정된다. 특히, 차동형 발룬의 LO 성분의 억압 정도는 공통-모드(common mode) 이득에 의해 결정되는데, 전류원(current source)의 출력 임피던스가 높을수록 LO 성분의 억압 정도는 개선된다. 이 차동형 능동 발룬의 이득은 두 트랜지스터 Q1과 Q2의 트랜스컨덕턴스(transconductance), degeneration 인덕터 L1, L2 및 출력 저항 R1과 R2에 의해 결정된다. Degeneration 인덕터 L1, L2은 입력 발룬 회로의 선형성 향상을 위해 사용되었으며, 커패시터 C1은 접지(ground)와 DC 바이어스 분리를 위하여 사용되었다.

그림 8[8]은 degeneration 저항이 있는 공통-에미터와 공통-컬렉터가 캐스코우드(cascode)로 연결된 푸쉬-풀(push-pull)형 발룬 회로로서, 길버트 셀 믹서의 출력 단에 연결되어 차동 신호를 단일 신호로 변환한다. 발룬의 이득은 두 신호 path 이득의 합이며, degeneration 저항 R3는 공통-에미터 path의 이득을 조절하고 LO 누설의 최대 상쇄(cancellation)를 유도하며, R4는 출력 임피던스 매칭시 포함된다. 공통-컬렉터는 높은 선형성을 제공하며 공통-에미터 또한 동일한 바이어스 전류와 컨덕턴스를 갖는 차동형 회로에 비해 선형성이 우수한 것으로 알려져 있다[9]. 이들 능동 발룬들은 좋은 격리(isolation) 특성을 제공하는데, 본 논문에서는 이들 능동 발룬들은 능동믹서 회로와 함께 설계되고 집적화 되었다.

그림 9는 이미 잘 알려진 대로 차동형 구조의 double-balanced 믹서로서 RF출력에서 IF와 LO 격리가 좋고, 출력 전력을 증가시킬 수 있으며, 두 입력 모두 차동 입력의 발룬을 필요로 한다. 이 믹서의 경우 두 입력이 180도의 차동 신호를 가지고 구

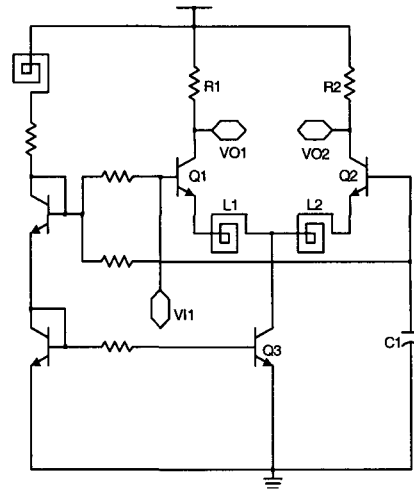


그림 7. 바이어스 회로를 포함한 IF/LO 입력 발룬 회로

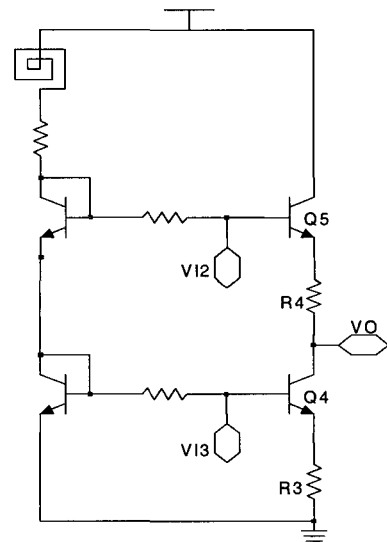


그림 8. 바이어스 회로를 포함한 RF 출력 발룬 회로

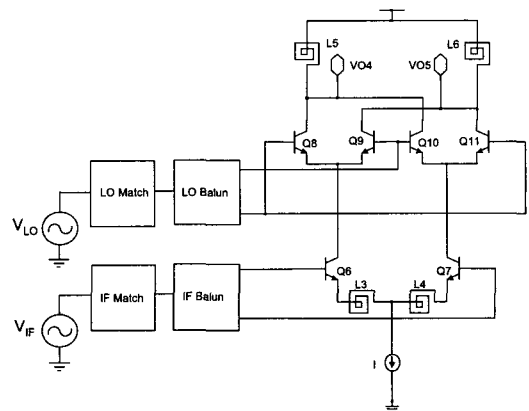


그림 9. Emitter inductive degeneration이 있는 믹서코어.

동될 때, 출력에 LO와 IF 누설이 없게 된다. 변환 이득은 트랜지스터 Q6과 Q7의 트랜스컨덕턴스(trans-conductance), degeneration 인덕터 L3, L4 및 컬렉터 인덕터 L5과 L6에 의해 좌우된다. 또한, Degeneration 인덕터 L3, L4는 잡음을 고려하고 선형성 개선을 위해 삽입되었으며, 인덕터 L5와 L6는 전압 headroom을 얻기 위하여 컬렉터 부하로서 사용되었다. 앞서 언급된 발룬 회로들과 믹서회로의 DC 바이어스에는 안정적인 전류 공급을 위하여 전류 미터 회로를 이용하였으며, 입력 및 출력은 모두 50Ω 경합을 하여 설계하였다.

IV. 5.8 GHz SiGe 상향믹서 제작 및 측정

이 절에서는 앞서 언급된 SiGe 능동소자와 수동 소자를 이용하여 설계하여 제작한 측정결과를 중심으로 설명한다. 그림 10은 그림6의 DSRC 송신기용 5.8 GHz 상향믹서 구조를 그림 7, 그림 8 및 그림 9의 회로로 구현된 칩의 사진으로, 칩 크기는 2.7 mm X 1.6 mm이다. 그림 10에서 위 3개의 패드는 전압 공급용이며, 왼쪽, 아래쪽 및 오른쪽 패드는 각각 LO 입력, IF 입력 및 RF 출력용이며 온 웨이퍼(on wafer) 측정을 위해 GSG 형태로 배치하였다.

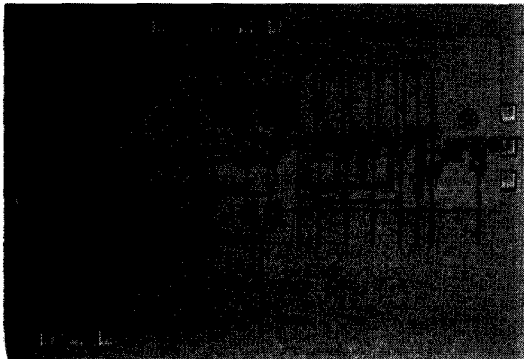


그림 10. 제작된 5.8 GHz SiGe 상향믹서의 칩사진.

주파수 스펙트럼 측정을 위하여, RF power source 및 RF Synthesized Sweeper HP83650B, HP83752B 와 스펙트럼 분석기 HP8563E가 사용되었으며, 제작된 믹서는 공급전압 3.0 V(국부 바이어스 공급전압 VA=3.0 V 및 VB=2.5 V 포함)에서 측정되었다. 그림11은 IF 입력에 -25 dBm, LO 입력에 5.0 dBm 을 인가하고, RF 출력 포트에서 100 MHz~7.0 GHz 사이에서 측정된 주파수 스펙트럼을 나타낸 것이다.

그림 11의 아래 그림은 RF 중심주파수 5.790 GHz 를 포함하고 50 MHz 간격 만을 확대하여 출력한 스펙트럼 측정결과로서, 전력 변환 이득은 케이블 및 커넥터 손실 2 dB를 보상하여 3.5 dB를 얻었다. 또한, LO to IF isolation은 42 dB, LO to RF isolation은 38 dB로 측정되어 포트간 격리 특성이 우수함을 확인할 수 있었다. 그림 12는 LO 입력에 5.0 dBm을 고정시킨 상태에서 IF two-tone 입력을 -25 dBm에서 3 dBm 까지 sweep하여 IP3를 측정 한 결과로서 OIP3는 -12.5 dBm이다. 이들 측정결과 들을 종합하여 표 3에 요약하였다. 참고로, 본 논문에서 사용한 회로 규격(specification)은 시스템 시뮬레이션을 통하여 내부적으로 도출된 것이며 상용화된 제품이나 기 발표된 논문의 결과들과는 회로 규격이 다르므로 비교대상으로 삼지 않았다.

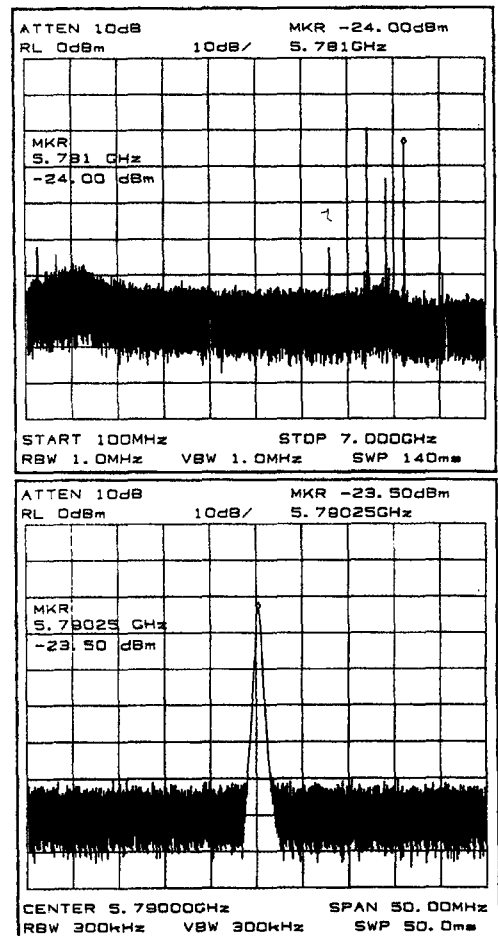


그림 11. RF 출력 포트에서 측정된 주파수 스펙트럼. (상: 100 MHz~7.0 GHz range, 하: 50 MHz span)

참고문헌

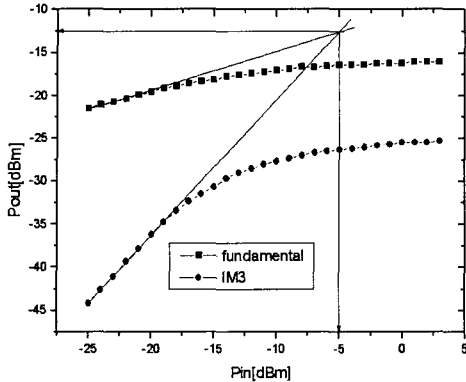


그림 12. LO=5 dBm에서 IF 전력 sweep에 따른 IP3 측정 결과.

표 3. 제작된 5.8 GHz 상향믹서의 측정결과 요약.

parameters	simulated	measured
IF frequency [MHZ]	284	284
LO frequency [GHZ]	5.506	5.506
conversion gain [dB]	5.0	3.5
LO to IF isolation [dB]	62	42
LO to RF isolation [dB]	67	38
OIP3 [dBm]	-7.0	-12.5
IC [mA]	27	29

V. 결론

근거리무선통신(Dedicated Short Range Communication, DSRC)은 근거리 영역의 노변장치(Road Side Equipment, RSE)와 차량탑재장치 (On-Board Equipment, OBE)와의 고속통신을 수행하는 통신시스템이며, 앞으로 대부분의 지능형교통시스템 서비스는 근거리무선통신에 의해 제공될 것으로 보여인다. 본 논문에서는 SiGe 이종접합 트랜지스터를 사용하여 5.8 GHz 근거리무선통신 송신기용 상향믹서를 설계 및 제작하여 보았다. 설계 및 제작된 5.8 GHz 상향믹서는 믹서 코어회로와 더불어 IF/LO/RF 정합 회로, RF/LO 입력 발룬과 IF 출력 발룬 회로가 단일칩으로 구현되었으며, RF SoC 관점에서 실현해 보았다. 제작된 5.8 GHz 상향믹서는 2.7 mm X 1.6 mm의 크기를 가지며, 3.5 dB의 전력변환이득과 -12.5 dBm의 OIP3, 42 dB의 LO to IF isolation, 38 dB의 LO to RF isolation, 3.0 V의 공급전압 하에서 29 mA의 전류소모로 측정되었으며, 특히 LO 격리 특성이 우수하였다.

- [1] H. Oh, C. Yae, D. Ahn, and H. Cho, "5.8 GHz DSRC packet communication system for ITS Services," *IEEE Vehicular Technology Conference*, pp. 2223-2227, 1999.
- [2] E.C. Low, K. Yan, H. Nakamura, H. Fujishiro, "A plastic package GaAs MESFET 5.8-GHz receiver front-end with on-chip matching for ETC system," *IEEE Tran. on Microwave Theory and Techniques*, 48(2), pp. 209-213, Feb. 2000.
- [3] S.-Y. Lee, H.-S. Kim, S.-H. Lee, K.-H. Shim, J.-Y. Kang, M.-K. Song, "The behavior of Ti silicidation on Si/SiGe/Si base and its effect on base resistance and fmax in SiGe hetero-junction bipolar transistors," *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, 12(8), pp. 467-472, August 2001.
- [4] B. Razavi, *RF Microelectronics*, Prentice Hall, Inc., pp. 166-204, 1998.
- [5] B. Gilbert, "The multi-tanh Principle: A tutorial overview," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 33(1), pp. 2-17, Jan. 1998.
- [6] S.-H. Lee, J.-Y. Lee, S.-Y. Lee, C.W. Park, S.H. Kim, H.-C. Bae, J.-Y. Kang, K.-I. Cho, "A 5.8 GHz Mixer using SiGe HBT Process," *Conference Proceedings of 33rd European Microwave Conference*, vol. I, pp. 403-406, Oct. 2003.
- [7] D.W. Suh, B.K. Mheen, J.Y. Kang, and M.C. Paek, "Enhancement of Q factor in parallel-branch spiral inductors," *Journal of the Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers*, 16(1), pp. 83-87, Jan. 2003.
- [8] D.-Y. Kim, S.-G. Lee, J.-H. Lee, "Up-conversion mixer for PCS application using Si BJT," *IEEE 2nd International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology Proceedings*, pp. 424-427, 2000.
- [9] K.L. Fong and R.G. Meyer, "High-frequency nonlinearity analysis of common-emitter and differential-pair transconductance stages," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 33(4), pp. 548-555, April 1998.

이 상 흥 (Sang heung Lee)

정회원



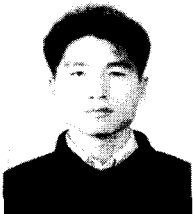
1988년 2월 충남대학교 전자
공학과 졸업 (공학사)
1992년 2월 충남대학교 전자
공학과 졸업 (공학석사)
1998년 2월 충남대학교 전자
공학과 졸업 (공학박사)
1998년 4월~1999년 6월 한국

전자통신연구원 회로소자기술연구소 박사후 연수
연구원(Post Doc.)

1999년 7월~현재 한국전자통신연구원 기반기술연
구소 고속집적회로연구부 SiGe소자팀 선임연구원
<관심분야> RF 집적회로 설계, 고속 디지털 집적회
로 설계, 반도체소자 모델링 및 변수추출

이 자 열 (Ja yol Lee)

정회원



1998년 2월 건국대학교 전자
공학과 졸업 (공학사)
2000년 2월 충남대학교 전자
공학과 졸업 (공학석사)
2005년 2월 충남대학교 전자
공학과 졸업 (공학박사)

2001년 3월~현재 한국전자통
신연구원 기반기술연구소 고속집적회로연구부
SiGe소자팀 선임연구원

<관심분야> VCO, PLL, OEIC 회로 설계

김 상 훈 (Sang hoon Kim)

정회원

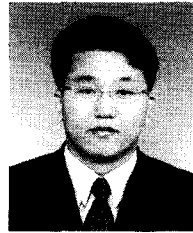


1995년 2월 홍익대학교 금속
재료공학과 졸업 (공학사)
2000년 7월 홍익대학교 금속
재료공학과 졸업 (공학석사)
2000년 8월~현재 한국전자통
신연구원 고속집적회로연구부
SiGe소자팀 연구원

<관심분야> SiGe 단결정 성장, SiGe를 이용한 HBT
& BiCMOS 소자공정

배 현 철 (Hyun cheol Bae)

정회원

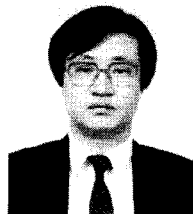


1999년 2월 동국대학교 전자
공학과 졸업 (공학사)
2001년 2월 동국대학교 전자
공학과 졸업 (공학석사)
2001년 3월~현재 한국전자통
신연구원 고속집적회로연구부
SiGe소자팀 연구원

<관심분야> SiGe BiCMOS RFIC 설계, 수동소자
설계

강 진 영 (Jin yeong Kang)

정회원

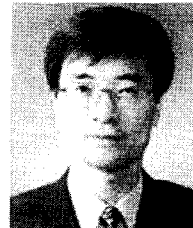


1977년 2월 서울대학교 천문
학과 졸업 (이학사)
1979년 2월 한국과학기술원 물
리학과 졸업 (이학석사)
1991년 2월 한국과학기술원 물
리학과 졸업 (이학박사)

1979년~현재 한국전자통신연구
원 기반기술연구소 SiGe 소자팀 팀장/책임연구원
<관심분야> SiGe 반도체, 반도체소자공정

김 보 우 (Bo woo Kim)

정회원



1975년 2월 부산대학교 물리
학과 졸업 (이학사)
1978년 2월 부산대학교 물리
학과 졸업 (이학석사)
1978년~1981년 삼성반도체
연구원

1987년~1989년 Tokyo Univer-
sity 방문연구
1981년~현재 한국전자통신연구원 기반기술연구소
고속집적회로연구부 부장/책임연구원
<관심분야> 고집적 MOS/BiCMOS 소자 및 공정,
고속 바이폴라 소자 및 공정, VLSI 디바이스에
서의 박막특성 및 hot-carrier 효과 현상